



化 基 功 二

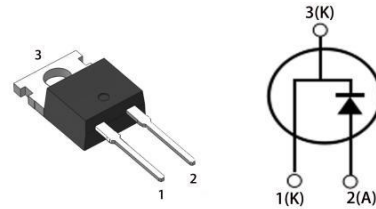
产品

， 于 使
不受 响 关
作 175°C
反向 复
向 复 压

产品		
≤157°C		

产品优

- 单 器件
- 大 低 关
- 器件中
- 低 对 依



域

- 关 (SMPS), 功 因 (PFC)
- 动, 光伏 变器, 不 ,
力发动 , 列 , 动 。



产品型号	封	
G5S06508AT	TO-220AC	G5S06508AT

定值

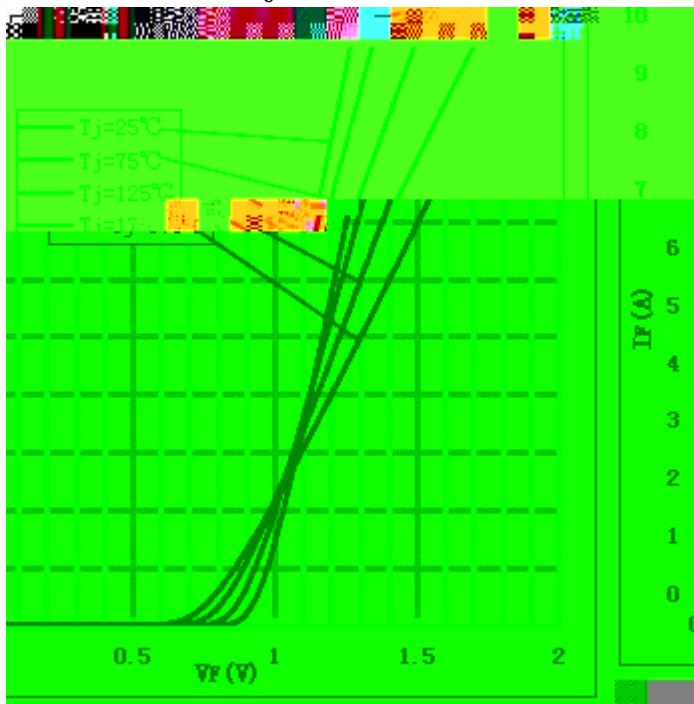
参		件	值	单位
反向复	V_{RRM}		650	V
反向	V_{RSM}		650	V
反向压	V_{DC}		650	V
向均	I_F	$T_C=25^\circ\text{C}$ $T_C=125^\circ\text{C}$ $T_C=157^\circ\text{C}$	30.5 16 8	A
向复	I_{FRM}	$T_C=25^\circ\text{C}$, $t_p=10\text{ms}$, Half Sine Wave, $D=0.3$	40	A
向不复	I_{FSM}	$T_C=25^\circ\text{C}$, $t_p=10\text{ms}$, Half Sine Wave	105	A
功	P_{TOT}	$T_C=25^\circ\text{C}$ $T_C=110^\circ\text{C}$	117 51	W W
作	T_j		-55°C to 175°C	$^\circ\text{C}$
	T_{stg}		-55°C to 175°C	$^\circ\text{C}$
安		M3 Screw 6-32 Screw	1 8.8	Nm lbf-in

学 , °C

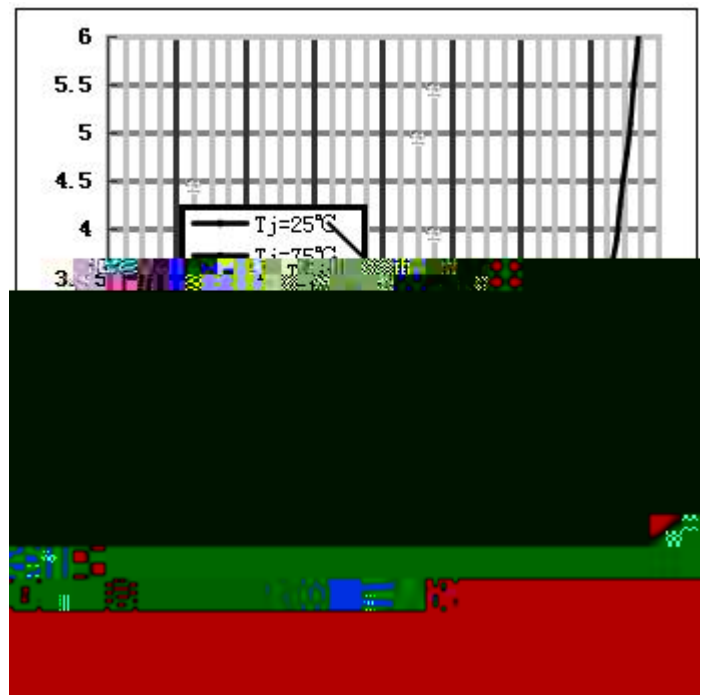
参	件	值		单位	
		典型值	大值		
向压	V_F	$I_F=8A, T_j=25^{\circ}C$	1.3	1.5	V
		$I_F=8A, T_j=175^{\circ}C$	1.6	1.8	
反向	I_R	$V_R=650V, T_j=25^{\circ}C$	0.25	50	μA
		$V_R=650V, T_j=175^{\circ}C$	1.5	100	
存储	Q_C	$V_R=400V, T_j=150^{\circ}C$ $= \int$	29	-	nC
容	C	$V_R=0V, T_j=25^{\circ}C, f=1MHz$	550	588	pF
		$V_R=200V, T_j=25^{\circ}C, f=1MHz$	60	65	
		$V_R=400V, T_j=25^{\circ}C, f=1MHz$	59	61	

图

1) 典型 向
 $I_F=f(V_F), T_j$ 为参



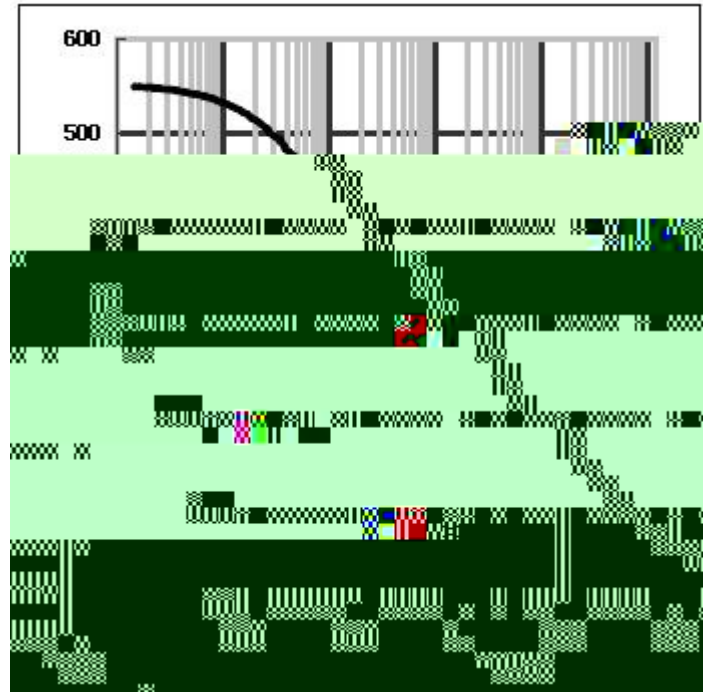
2) 典型反向
, 为参



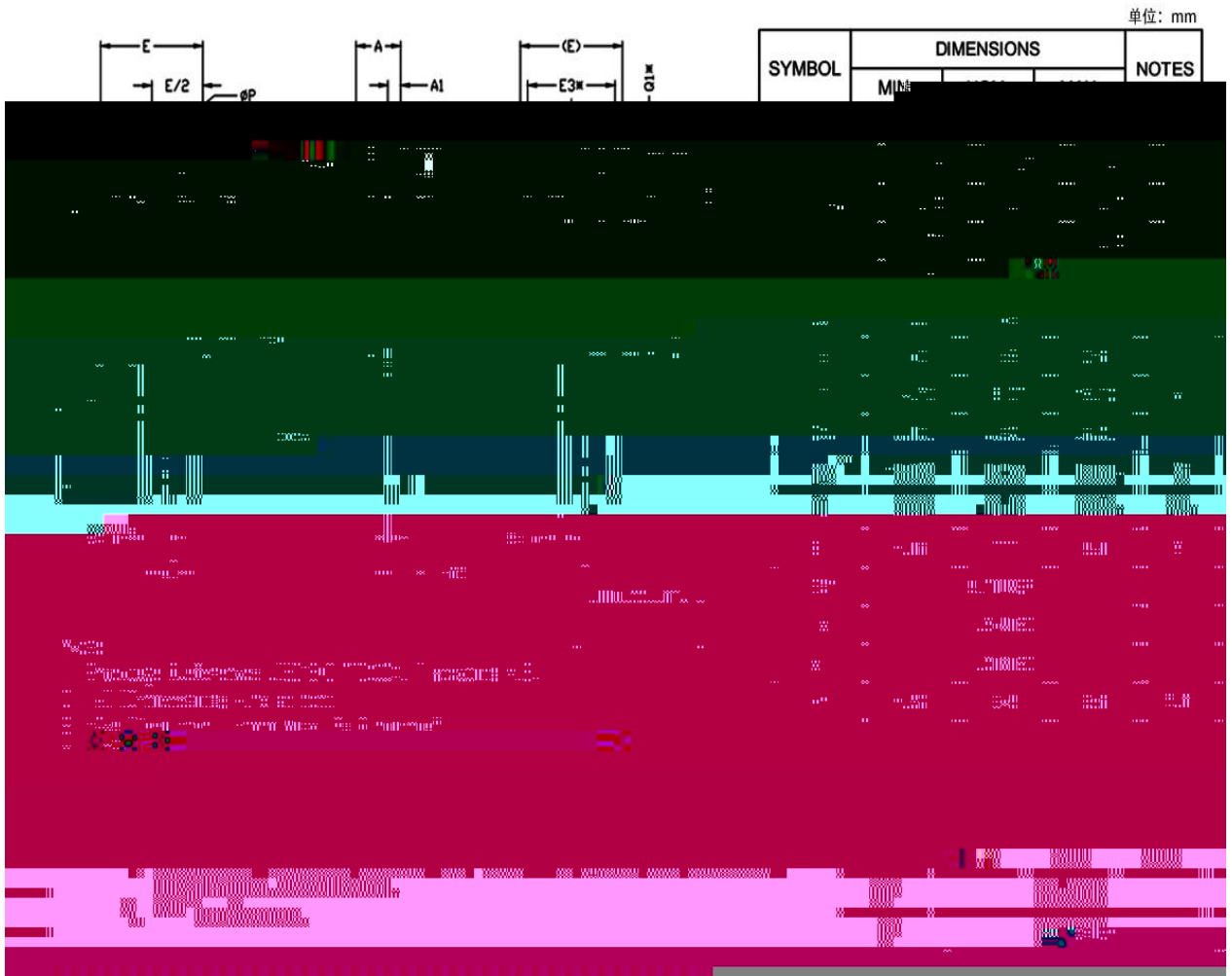
3) 不同 下 ()
(, , , ,)



4) 典型 容 反 向 压



封 _____ :



:

ISO9001: 2015 体 于 2015 9 23 实 。 ISO9000 准 国 准化 (ISO) 于 1987 在全世
围内 关于 和 保 列 准。 ISO9001 体 三 () 对企 体
审 、 定和 册 动, 其 在于 审 、 定和事后 企 体 合 ISO9001 准, 对 合 准
予合 书 予以 册 全 动。 天 半导体 (北京) 公司 ISO9001: 2015 以及其他 书信 可以
公司官 : <http://www.globalpowertech.cn/CompVisualize.asp>

多 产品信 和公司信 官 :

<http://www.globalpowertech.cn/>

